

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
30. Juni 2005 (30.06.2005)

PCT

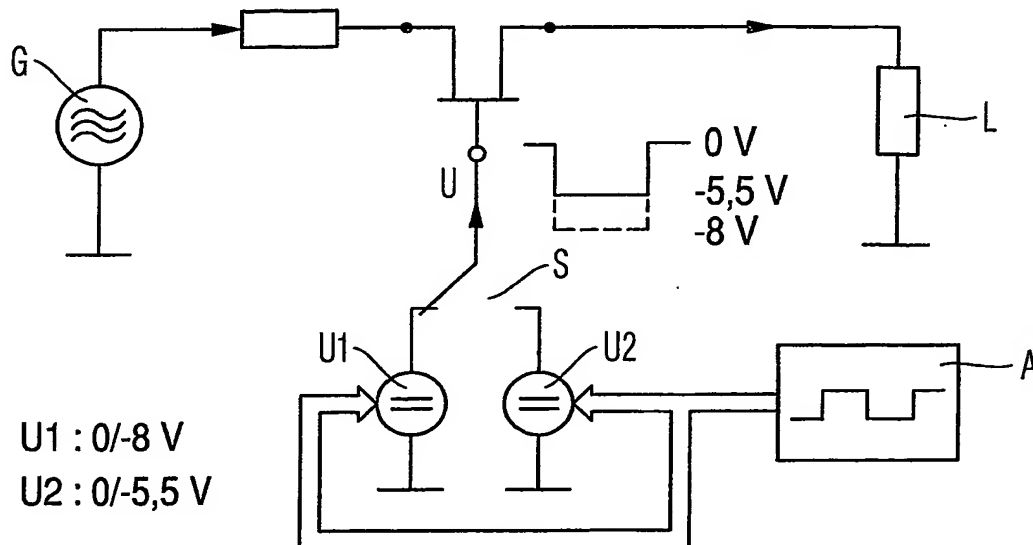
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/060096 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H03H 11/24** (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG** [DE/DE]; Mühlendorfstrasse 15, 81671 München (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2004/013540**
- (22) Internationales Anmeldedatum:
29. November 2004 (29.11.2004) (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **KRAEMER, Wilhelm** [DE/DE]; Müllnerhorngasse 1, 83435 Bad Reichenhall (DE).
- (25) Einreichungssprache: **Deutsch**
- (26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch** (74) Anwälte: **KÖRFER, Thomas** usw.; Mitscherlich & Partner, Postfach 33 06 09, 80066 München (DE).
- (30) Angaben zur Priorität:
103 59 298.9 17. Dezember 2003 (17.12.2003) DE
10 2004 005 531.9 4. Februar 2004 (04.02.2004) DE (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **ELECTRONIC HIGH-FREQUENCY SWITCH AND ATTENUATOR WITH SAID HIGH-FREQUENCY SWITCHES**

(54) Bezeichnung: **ELEKTRONISCHER HOCHFREQUENZ-SCHALTER UND EICHLEITUNG MIT SOLCHEN HOCHFREQUENZ-SCHALTERN**



(57) Abstract: The invention relates to an electronic high-frequency switch, comprising a field-effect transistor as switching element, whereby the size of the gate voltage may be switched between at least two values (- 5.5V or -8V), according to the desired linearity or switching speed. The switching device for the gate voltage is preferably coupled to a correction device in which different correction values for transmission or reflection of the high-frequency switch, corresponding to the different gate voltage values are stored.

(57) Zusammenfassung: Bei einem elektronischen Hochfrequenz-Schalter mit einem Feldeffekttransistor als Schaltelement ist die Grösse der Gate-Spannung je nach der gewünschten Linearität oder Schaltgeschwindigkeit zwischen mindestens zwei Werten (- 5,5V bzw. -8V) umschaltbar; vorzugsweise ist die Umschalteneinrichtung für die Gate-Spannung mit einer Korrekturereinrichtung gekoppelt, in welcher für die unterschiedlichen Gate-Spannungswerte entsprechend unterschiedliche Korrekturwerte für Transmission oder Reflexion des Hochfrequenz-Schalters gespeichert sind.

WO 2005/060096 A1



CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.